

★エッチング技術の基礎・メカニズムから先端エッチング技術まで幅広く解説！
☆エッチングにおける課題、課題解決へのアプローチを理解できる！

1名分料金で
2人目無料

ドライエッチングのメカニズムと最先端技術【LIVE配信】

セミナーURLはこちら→<https://www.rdsc.co.jp/seminar/2405117>

- ◆日時：2024年5月29日（水）13:00～16:00
- ◆アーカイブ配信はございません
- ◆受講料：1名につき49,500円（税込、資料付）

会員（案内）登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円（税込）から
・1名で申込の場合、**45,000円（税込）**へ割引になります。
・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計49,500円（2人目無料）**です。

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

【講師】

株式会社日立ハイテク プロセス企画部 部長
大竹 浩人氏

【講演の趣旨】

台湾 TSMC の熊本工場、北海道のラピダスの設立など半導体製造メーカの日本進出が進んできていますが、2 ナノメートルといった超微細な構造を加工するには、エッチング技術が欠かせません。刃物や研磨では得られない超微細加工を実現するためには原子・分子・イオンを活用したエッチング技術が必要であり、デバイス寸法の縮小に伴い、日進月歩の技術革新が行われています。本セミナーではエッチング技術の基礎・メカニズムの説明からスタートし、現在 Intel や TSMC, Samsung, SK Hynix など最新半導体デバイスを製造しているメーカが使用している先端エッチング技術までを紹介いたします。エッチング技術にも多くの課題があり、そのブレークスルー技術についてもご紹介いたします。

【プログラム】

- 1.エッチングの基礎
 - 1-1 微細加工
 - 1-2 プラズマの生成とエッチング
- 2.異方性エッチング
 - 2-1 異方性エッチングのメカニズム
 - 2-2 異方性エッチング向け製造装置
- 3.等方性エッチング
 - 3-1 等方性エッチングのニーズ
 - 3-2 等方性エッチングへのアプローチ
 - 3-3 等方性エッチングの例
- 4.エッチングの高機能化- パルスプラズマ
 - 4-1 ソースパルス
 - 4-2 バイアスパルス
 - 4-3 シンクロナイズドパルス
- 5.エッチングの課題
 - 5-1 形状異常
 - 5-2 プラズマ誘起ダメージ
 - 5-3 量産における課題
- 6.最新エッチング技術
 - 6-1 ロジックデバイス向けエッチング技術
 - 6-2 メモリデバイス向けエッチング技術

『ドライエッチング』セミナー申込書 FAX:03-5857-4812

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録（無料） ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>